

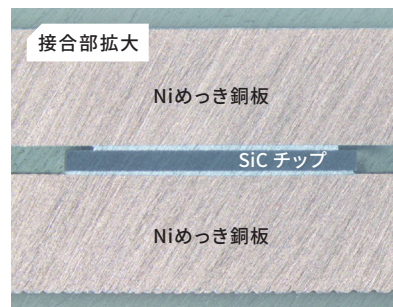
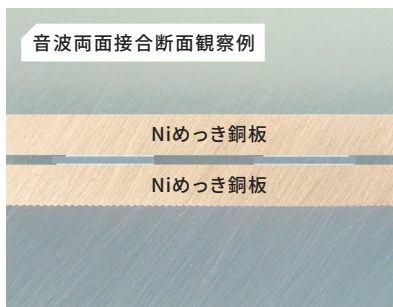
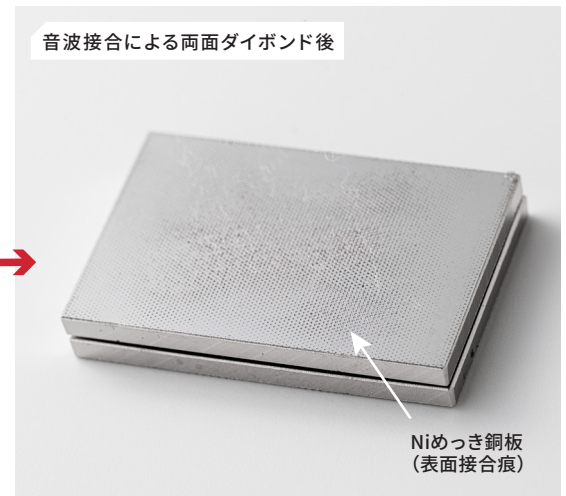
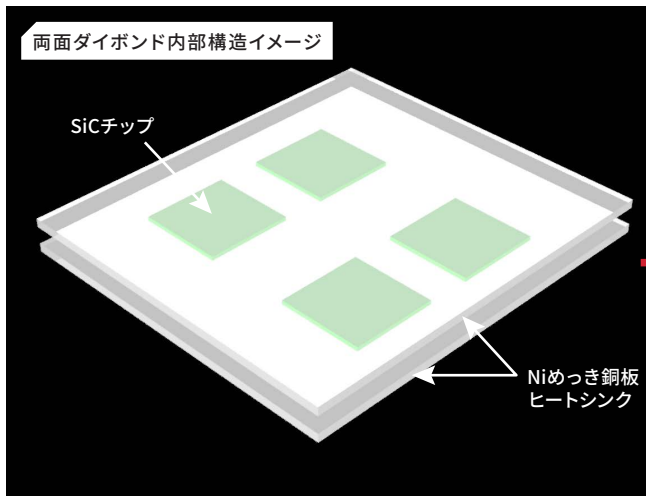


Patented

Application

Bonding ボンディング

ヒートシンクに挟まれたパワー半導体SiCチップの音波接合による両面ダイボンド



4個のSiCが
2枚のNiめっき銅板の間に
両面ダイボンドされた
[SiCパッケージ]

Point ここがポイント

- ▶ 異種材料を重ねた [3DB&DMB] 接合
- ▶ SiCチップとNiめっき銅ヒートシンク間の接合
- ▶ 音エネルギーのみで接合 接着剤や金属ペーストの加熱不要
- ▶ ヒートショックテストクリア (-50~600°C)
- ▶ 大気中常温接合
- ▶ 接合のエネルギー源は電気とエアのみ
- ▶ デスクトップ接合

Product used 使用する装置

- ▶ 15MZs



AP-J-0097A4-2025041001